

特別ロングインタビュー

東北大学教授 理学博士 川添 良幸氏



分子エレクトロニクスの進展に大きく寄与

と聞いています。今後は力一
ボンサンチューブの構造を
変えることで、トランジス
ター機能を持たせることも
できると考えています。

一方で、世界を驚かせ
る高レベルの演算能力を持つ
シリコンフラーの発見
ですが。

川添 フラーレンは炭素
原子が六個、環状にな
がった直角七オングスト
ロームの中空粒子で、カーボンのフラーレン素材は誰
も確認できなかった。我々
は、第一原理シミュレーション計算による、金属原子
一個を内包する最小の範型
も重要であるが、とにかく

この登場してすでに五十年
を超えた。この間、半導体
技術の発展に伴って、あら
ゆる電子機器が発明され歴
史を作つていった。しかし
二世紀に入っていよいよ
次へのステップに踏みま
ねばならない。それが、
ナノテクノロジーを応用し
た量子デバイスの世界であ
る。今回このシリコンフ
ラーの発見者である東
北大金属材料研究所の川
添良幸博士にお話を伺っ
た。

—二世紀は電子レベルのデバイスの時代といわれますが、この分野の研究の発展は目覚しいですね。
川添 これは全く実験的で、シリコンフラーの発見である。これは半導体の研究者やまた企業にインパクトを与えた。今回このシリコンフラーの発見者である東北大金属材料研究所の川添良幸博士にお話を伺つた。

世界を驚かせた「シリコンフラー」の発見

アジア地区で計算機材料設計コンソーシアム

だ。

—このシリコンフラーの発見を初めて、ナノテクノロジーの研究開発では日本は〇・一レベルで大きな影響を与えますね。

川添 半導体の微細加工コーンは現在の半導体の基礎材料であり、安価で大量に作れる素材だ。シリコンフラーはこの〇・一〇分の一の微細加工を目指している。しかし、知的財産が流出すればどうはいかない。量子デバイスによる分子エレクトロニクスを確立することこそ、日本の国

策の持つ知識財産が歐米に流出している現状を憂れていますから、これまでも画期的な研究成果が全て英語で、米国において発表されるスタイルが多かった。しかしヨーロッパはこの通りだ。今年一月に導入した日立製作所製のSRS8000(六四)より、少ない基底数で精度な状態表現可能となる。これが全電子混合基底法といふもので、混合基底波動関数(電子軌道平面波)による局構造緩和も可能だ。

—一方で、スマートフォンによるところが大変なところだ。実際にそれが金電子混合基底法といふもので、混合基底波動関数(電子軌道平面波)による局構造緩和も可能だ。

川添 昨年は仙台で開催され、今年は二月にインドのバンガロールで開催される。画期的科学技術を日本およびアジアエリートに蓄積していくことが重要だ。ちなみに私の研究室には中国、印度、アメリカ、ド

イツ、イラン、ロシア、タイ、オランダの各国から研究者が来ており、多才な人々がいる。

—一方でスマートフォンによるところが大変なところだ。実際にそれが金電子混合基底法といふもので、混合基底波動関数(電子軌道平面波)による局構造緩和も可能だ。

川添 そこが勝負を分け

ジアの持つ知識財産が欧米に流出している現状を憂れていますから、これまでも画期的な研究成果が全て英語で、米国において発表されるスタイルが多かった。しかしヨーロッパはこの通りだ。実際にそれが金電子混合基底法といふもので、混合基底波動関数(電子軌道平面波)による局構造緩和も可能だ。

—一方でスマートフォンによるところが大変なところだ。実際にそれが金電子混合基底法といふもので、混合基底波動関数(電子軌道平面波)による局構造緩和も可能だ。

川添 そこが勝負を分け

るところだ。実際のところ、埋め込み原子配線表

（本紙編集長 泉谷涉）

(仙台市青葉区片平二十一
一、☎022-1251-2050)は、金属の密林の開拓者として知られる本多光太郎氏(文化勲章の初代受賞者)によって創立され、わが国の鉄道学の基礎を作つた存在として世界にその名を知られている。二〇〇一年七月三日、この金属材料研究所からまたもや世界を驚嘆させる発表が行われた。シリコンフラーの発見である。これはPhysical Review Letter紙に技術の発展に伴つて、あらゆる電子機器が発明され歴史を作つていった。しかし量子デバイスの実用化に大きな道を開いたものとして、世界中の研究者やまた企業にインパクトを与えた。今回このシリコンフラーの発見者である東北大金属材料研究所の川添良幸博士にお話を伺つた。

—二世紀は電子レベルのデバイスの時代といわれますが、この分野の研究の発展は目覚しいですね。
川添 これは全く実験的で、シリコンフラーの構造は中心に注入したカーボンナノチューブによるダイオード機能を確認していますね。

—二世紀は電子レベルのデバイスの時代といわれますが、この分野の研究の発展は目覚しいですね。
川添 これは全く実験的で、シリコンフラーの構造は中心に注入したカーボンナノチューブによるダイオード機能を確認していますね。